

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-179482

⑮ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)8月6日

A 63 C 5/052

6777-2C

審査請求 有 発明の数 1 (全2頁)

⑭ 発明の名称 スキー

⑯ 特 願 昭61-20340

⑰ 出 願 昭61(1986)2月1日

⑱ 発 明 者 羽 生 田 康 二 長野市真島町真島174番地

⑲ 出 願 人 羽 生 田 康 二 長野市真島町真島174番地

明 細 書

1. ^{発明}~~考案~~の名称

スキー

2. ^{特許}~~実用新案登録~~請求の範囲

スキーの滑走面の先端部の接地部分でその両側面エッジに凸状エッジを設けたことを特徴としたスキー。

3. ^{発明}~~考案~~の詳細な説明

本^{発明}~~考案~~はスキーに関するものである。ウィンタースポーツであるスキーは大衆化し、スキー滑走技術を高度にマスターした人口が年々増加している。しかしながら、冬期間に一、二度グレンデスキー場を訪れるスキーヤーに取っては毎年初級スキーでいることに少々自分の持つ練習不足を他にし養み見学にいとわない場合がある。そこで本^{発明}~~考案~~は諸々の事情でスキーをする時間を充分に取れず、必然に毎年初級者であることを解放可能にしたスキーを提供するものである。次に本^{発明}~~考案~~を一実施例の図面によって詳細に説明をする。

第1図は従前の一実施例の側面断面図である。スキー1にくつ金具2を設けて且つ水平地面3にスキー1の滑走面を置くとその前部および後部に接地点a、接地点b 非接地点cを有して湾曲を形成し且つ両側面に縦長なエッジを設けて、スキー1は構成されている。第2図は第1図の底面図である。底面はスキー1の滑走面であって、その中央部分に縦長の溝dを設けて且つ前部の接地点aには前記溝は通っていない。両側面にはエッジeを設けてある。2はくつ金具である。滑走回転を左または右に回転する際に回転の外側になっているエッジeを雪面に対してその効果を外ずし同時に前部接地点aを回転の支点になる様に体重を掛けながら回転をする技術の修得は、ハードな練習訓練が必要である。第3図は本^{発明}~~考案~~の一実施例の側面断面図である。基本的には第1図のスキー1と同様であるが、前記した滑走回転を極めて容易に可能ならしめるためにスキー1の前部接地点aの両側面エッジに凸状エッジを設けてこの前部接地点aの滑走回転の支点の効果を増強させた

ものである。滑走回転の際に左または右へ回転動作（クリスチャニア時のスキーのテール振り体重を抜きつついてその回転の外側に体重を掛けひざをその回転の内側へ押し込み曲げ滑走する）を該凸状エッジによって、スキーテールへの荷重を抜きテール振りが極めて容易に実現出来る。前部接地点aの両側における該凸状エッジfは滑走中の安全と回転の支点効果とは比例し難い点があるので、滑走滑走を基本に考へて該回転の支点の効果を大きくするとその支点における抵抗が増大し転倒し危険であるのでクリスチャニアのテール振りの起動が危険でない範囲内で容易に出来る滑走抵抗を示していれば充分である。第4図は第3図のA-A部分の断面図である。第5図は第3図の底面図である。以上の様にして、本~~発明~~^{本明}の一実施例によれば、スキー1の前部接地点aの両側面に凸状エッジfを設けて滑走回転を極めて容易に出来てスキー初心者 初級者であっても、従前のハードトレーニングを短縮して、スキーの技術を早く修得可能になった等の特徴を有している。

4. 図面の簡単な説明

第1図... 従前の一実施例の側面断面図。第2図... 第1図の底面図。第3図... 本~~発明~~^{本明}の一実施例の側面断面図。第4図... 第3図のA-A部分の断面図。第5図... 第3図の底面図。

1... スキー。2... くつ金具。3... 水平地面。

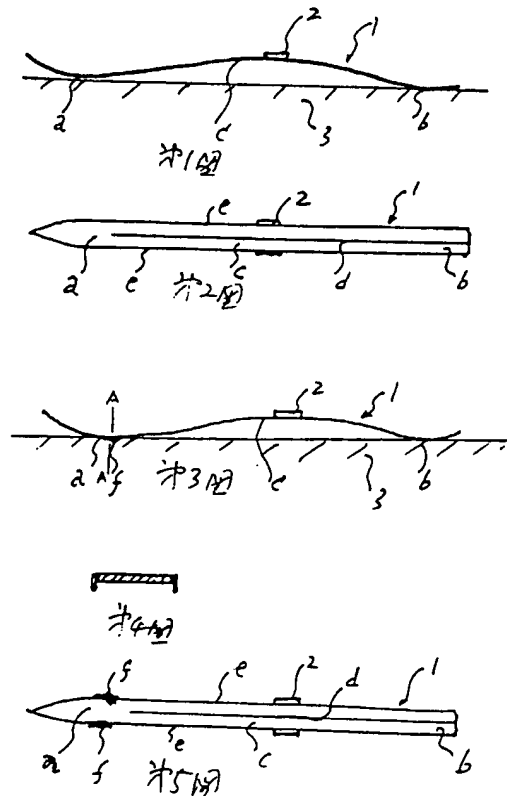
a... 前部接地点。b... 後部接地点。o... 非接地面。

d... 縦長の溝。e... 両側面のエッジ。f... 前部接地点aの両側面に有した凸状エッジ。

以上

特許
実用新案登録出願人

羽生田 廉二



MENU

SEARCH

INDEX

JAPANESE

1 / 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **64-022051**
(43)Date of publication of
application : **25.01.1989**

(51)Int.Cl. **H01L 21/94**
H01L 21/76

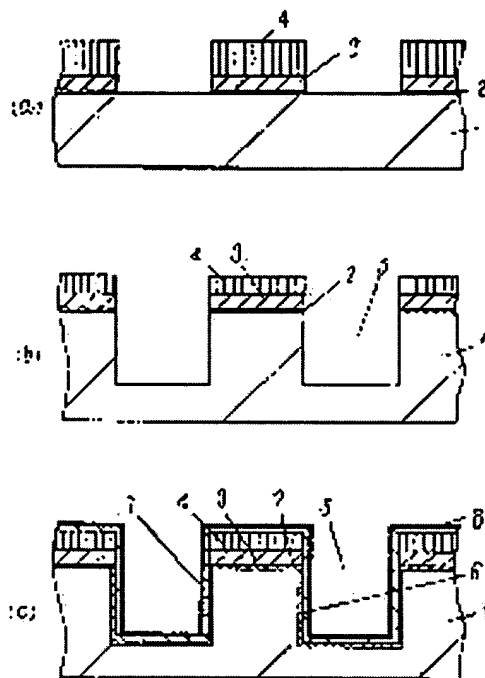
(21)Application number :	62-179482	(71) Applicant :	MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
(22)Date of filing :	17.07.1987	(72)Inventor :	TAMAOKI NORIHIKO KUBOTA MASABUMI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the acid resistant mask from being etched in the later isotropical etching process by a method wherein, after a silicon nitride film as a second acid resistant film is formed on the whole semiconductor substrate surface, the surface of this silicon nitride film is oxidized to form a silicon oxide film as an anti-etching mask which is thin and has no pin holes.

CONSTITUTION: On an N-type substrate 1, a thermal oxide film 2, a silicon nitride film 3 and a silicon oxide film 4 are sequentially formed, and with the silicon oxide film 4 as a mask they are etched to form opening parts 5. With the silicon nitride film 3 as a mask a thermal oxidation is performed to form a thermal oxide film 6 on the side and bottom of the opening parts. Thereafter, a silicon nitride film 7 is formed on the whole surface by a low pressure CVD method or the like, and subsequently a heat treatment is performed in an oxidation atmosphere to oxidize the surface of the silicon nitride film 7, thereby forming a silicon oxide film 8. With this, even if there are pin holes in the silicon oxide film which is later deposited on the silicon nitride film 7, the etching of the silicon nitride film 7 is prevented since the silicon oxide film 8 acts as an anti-etching mask in the isotropical etching process.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]